apin/on Special Topic · 專题

電子技術

63

# 解決準方波諧振電源 的谷底跳頻問題

作者。Stéhanie Cannenterre 關鍵学,安森美半導體、準方波器振轉換器。QR、電磁干擾、MOSFET

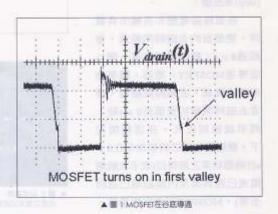
半方波譜振轉換器也稱作準證張(QR)轉換器,使 反激式開闢電源(SMPS)設計的試驗電磁干擾(EMI) 更低及滿載能效更高。然而, 由於負載下降時開 關頻率升高,必須限制頻率漂移,避免額外的開 關損耗。傳統準證振控制器採用頻率到位元技術 來限制頻率漂移。當系統開關頻率到達頻率鉗位 元限制值時,就發生容底跳頻:控制器在兩種可 能的容底頻率選擇中來回跳動,導致變壓器工作 不穩定及產生雜訊。克服這個問題的一種新技術 是在負載降低時改變谷底頻率,從而逐步降低開 關頻率。一旦控制器選擇某個谷底,它就保持鎖 定這個谷底頻率, 直列輸出功率大幅變化:這就 是安森美半導體新近引入的客底鎖定技術。 泛用於筆記型電腦適配器或電視電源。這種架構 的主要特徵就是零電壓開關(ZVS)工作,這種技術 能降低開闢損耗,說明弱化電磁干擾訊號。變壓 器去磁完成後,在電壓位於MOSFET漏極節點處 存在的電感電容網路滸振導致的自由振盪(即"谷 底開關")的最低値時導通MOSFET,從而實現 ZVS工作(圖1)。這個網路實際上由初級電感L,和 漏極節點處的寄生電容C,,,組成,如圖1。

準諾振電源的開關頻率取決於負載條件,本 質上變化幅度很大。不利的是,負載降低時開關

本文除了簡要介紹準請振電源,還將進一步 關釋谷底跳頻問題,介紹解決這問題的谷底續定 技術,並分享實驗結果支援理論研究的的實際應 用案例。

## 準方波訊號簡介

準方波諸振電源通常也稱作準諮振電源,廣



專題·Special Topic 2011/01

頻率增加,導致輕載能效欠佳, 因為開關損耗的預算增加了。要 改善輕載能效,必須找出方法來 將開關頻率鉗位元降至更低。

### 傳統準諧振轉換器

ET

電子技術

64

傳統準諧振控制器包含內部 計時器,防止自激(free-running)頻 率超過上限。頻率限制值通常固 定為125kHz,從而使頻率保持在 CISPR-22EMI規範的150kHz起始 點頻率之下。圖2是帶有8µs計時 器以錯位元開關頻率的準諧振控 制器的內部架構簡圖。

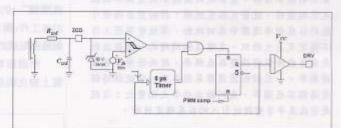
為了導通MOSFET,不僅要 以過零檢測(ZCD)比較器來檢測谷 底,而且8 µs計時器還必須已經 結束計時(圖2)。如果在8 µs的時 間視窗內出現谷底,就不允許 MOSFET啓動。因此,功率 MOSFET的關閉時間只能通過一 個自由振盪週期內的不同階躍 (step)來改變。

在低線路電壓和高輸出負載 時,變壓器的去磁時間較長,會 超過8μs:控制器將在第一個谷 底導通MOSFET。然而,隨著功 率需求降低,去磁時間縮短,而 當去磁時間縮短至低於8μs時, 頻率就被鉗位元。在這種情況 下,變壓器的磁芯將被指示在8μ s計時器結束之前復位(表示次級端 電流已經到零及內部磁場已返回 至零)。MOSFET不會立即重啓, 8μs時間視窗會使MOSFET保持在阻斷狀態,而某些谷底含被忽略。如果輸出功率電平使得逐週期能量平衡所需關閉時間降到兩個鄰近谷底之間,電源將以大小不等的開闢週期工作;這就是所 謂的谷底跌頻。較長的開闢週期會被較短的開闢週期補償,反之 亦然。在圖3中,2或3個週期的第一種谷底開闢之後,跟隨的是1 個週期的第二種谷底開闢。谷底跳頻現象使開闢頻率產生很大變 化,而這變化會被大峰值電流跳變補償。而電流跳變導致變壓器 中產生可聽雜訊。

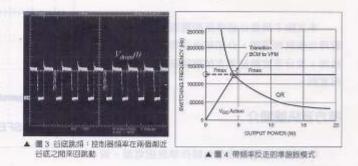
單獨鉗位元開關頻率可以解決輕輪出負截條件下的不穩定問 題,但不會改善該特定工作點的能效。因此,傳統準諧振轉換器 中,頻率銷位元要應涉及跳過期電路,要應涉及頻率反走電路。

# 頻率反走

頻率反走電路通常是壓控振盪器(VCO),在頻率鉗位元時降 低開腸頻率(圖4)。通過降低工作頻率,開腸損耗也得以降低,輕 載能效相應改善。然而,在頻率反走模式期間,MOSFET導通事 件仍然與谷底檢測同步;控制器頻率在兩個鄰近谷底之間來回跳







2019/01 Special Topic · 專题

65

動時發生穀底跳頻,同樣導致準諧振電源中出現 可聽雜訊。

這種技術帶來的另一項約束就是滿載和輸入 電壓較低時最低頻率的選擇。實際上,頻率鉗位 元要求選擇較低的最低頻率,而且這個值必須高 於可聽頻率範圍(通常約30kHz)。由於這較低的最 低頻率,初級電感值因而增加以提供必要的輸出 功率,變壓器尺寸也相應地增大。

### 解決谷底跳頻問題

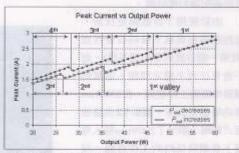
一種避免谷底跳頻問題的新方案,是在輸出 負載變化時,從某個谷底位置變到下一個/前一個 谷底位置,並將控制器頻率鎖定在所選位置。這 叫數 "谷底鎖定"技術。一旦控制器選定在某個 谷底工作,它就保持鎖定在這個谷底,直到輸出 功率大幅變化。實際上,可以通過監測回饋電壓 V<sub>m</sub>來觀測輸出功率變化。需要計數器來給谷底計 數。谷底鎖定乃是通過使電源在特定輸出負載下 能有兩個可能的工作點來實現。因此,當輸出負 載值使逐週期能量平衡所需的關閉時間介於兩個 鄰近的谷底之間時,峰值電流允許增高到足以在 下一個谷底找到穩定的工作點。

由於使用了這種技術,谷底跳頻不穩定問題 就不再存在,而且變壓器中也聽不到可聽雜訊。 這種技術的另一特徵是其提供自然的開關頻率限 制。實際上,每次控制器谷底遞增時,頻率就以 不同階羅來降低,如圖5所示。開關頻率的降低取 決於自由振盪週期:

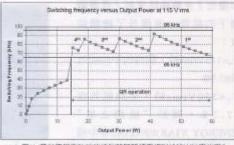
 $t_c = 2\pi \sqrt{L_p C_{hop}} \qquad (0,1)$ 

其中:L,是初級電感而Cume包括功率MOSFET 續極處存在的所有寄生電容(輸出電容Coss,變壓 器電容等)圖6描繪了使用帶谷底鎖定功能的控制 器(如安森美半導體的NCP1380)的適配器開關頻率 的變化過程。輸入電壓為均方根115V時,開關頻 率漂移限制在65kHz到95kHz之間,且不須使用任 何頻率鉗位元。

這種技術的另一優勢在於優化了整個負載/輸 入電壓範圍(特別是高輸入電壓條件下)的能效。 高輸入電壓時,不再有零電壓開關工作:開關損 耗增加。因此,舉例來說,在第二個谷底而不是 在第一個谷底工作或是在第三個谷底而不是在第 二個谷底工作更有優勢,從而使電源能夠以較低 的頻率開闢。**冒7**很好地描繪了這種情況,此圖中 顯示了控制器在第三個谷底或第四個谷底工作 時,輸出功率在24W到34W之間時的能效變化。 從圖中可以看出,在第四個谷底導通MOSFET提 供的能效比在第三個谷底專通MOSFET高出 0.3%。開關頻率在第四個谷底時比在第三個谷底 時低15kHz。



▲ ■ 5 就每個輸出負載而言,在2個報近的谷底中間尋為相應的工作點



▲ 圖 6 帶谷腔鎖定功能的控制器開闢領率相對於輸出功率的變化

專題·Special Topic 2011/01

在積體電路中應用谷底鎖定 技術

安森美半導體製造的準諾振 控制器NCP1379和NCP1380中應 用了谷底鎖定技術。實際上,使 用了一組比較器在回饋引腳監測 電壓,並將資訊饋送給計數器。 每個比較器上的磁滯會鎖定工作 谷底。因此,就給定輸出功率而 言,有兩種可能的工作點:確保 穩定工作而沒有谷底跳頻。為了 進一步提升輕載能效,基於壓控 振盪器的頻率反走電路在輸出功 率減小時降低開闢頻率。圖8顯示 的是NCP1380控制的19V、60W準 諸振適配器的電路圖。

ET

電子技術

6.6

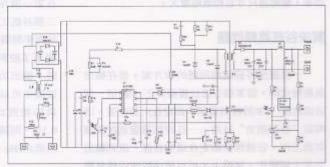
由於使用了答底銷定技術, 這控制器在負載下降時改變谷底 (從第一個谷底到第四個谷底),而 不會有任何不穩定問題。這幫助 擴展準譜振工作範圍,在230Vms 時功率低至20W。置9-12為篩檢 程式截圖,顯示了230Vms輸入電 壓下負載降低時的工作谷底。沒 有觀測到谷底跳頻。谷底鎖定技 術優化了完整線路電壓/負載範 圍下的能效,並提升了總體能 效:

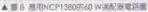
V<sub>4</sub>=115Vrms時,測得的平均能效 為87.9%

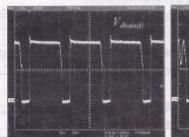
V<sub>a</sub>=230Vrms時,平均能效為 87.7%,高於"能源之星" (ENERGY STAR)EPA2.0標準中規 定的87%限制值輸出輕載時,通

Efficiency versus Output Power at 230 V rms lat d Z 85 Ethonoy 85.6 85 84.5 3rd veller 84 24.08 26.00 28.00 30.00 32:00 34.00 Output Pawer (W)

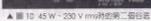
▲ 圖 7 第三個谷底工作和第四個谷間工作實際應用案例中的能效差異

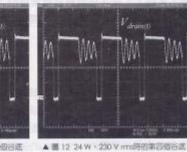






▲ 圖 9 60 W + 230 V rms時前第一個容氣





▲ 圖 11:30 W + 230 V rms特的第三级资底 ▲ 圖 12:24 W + 2

					2011/01 Special Topic •	厚
					14	
					1 m	
					a di ta sana anni antaria.	
		▼表1 建数能多			题,本文介紹了谷底鎖定技	
	1	115 Vrms		Vms	術。這種技術使電源能夠在給	
Pout (W)	Pla (W)	能效(%)	Pac (W)	能效(%)	定輸出負載條件下選擇兩個可	
1.0	1.290	77.6	1.340	74.6	能的穩定工作點,不僅不穩定	
0.7	0.923	75.9	0.965	72.2		
0.5	0.678	73.8	0.720	69.6	問題隨之消失,而且在結合使	
		▼ 表2 空戦語科	XXI'S	用壓控振盪器的情況下,這種		
		115 Vrins	230 Vrms P <sub>in</sub> (mW) 85		應用中的能效數值明顯升高。 基於NCP1380控制器的實際測 試結果證實了這種方法的有效	
	Pour (W) 0	P <sub>ie</sub> (mW) 59				
-			Ward Provide State	Same and the	性·	

過頻率反走電路進一步提升了能效。在0.7W輸出功率情況下,適配 器從交流主電源消耗的功率低於1W。表1總結了輕載時的能效:

頻率反走技術通過降低開關頻率,也降低了適配器在待機模式 (表示沒有輸出負載連接至適配器)下消耗的功率。230Vms時,適配 器在待機模式下從交流主電源(含X2電容的放電電阻)消耗的功率為 85mW,這對未配備高壓啓動電路的控制器而言是相當優秀的結果, 如表2。

# 結論

傳統準諧振控制器容易受到所謂的谷底跳頻問題的影響,因為 谷底跳頻會產生大小不同的開闢週期,並在變應器中產生可聽雜 訊。在某些線路電壓/負載條件下,當逐週期能量平衡所需的關閉時 間降到兩個鄰近谷底之間時,會出現谷底跳頻。為了解決這個問 安森業半導關應用工程師。 藝者資料 [1] 安森葉半導體網話。 www.orsem.com。 [2] NCP1379資料表。www.onsemi. com/pub\_link/Collateral/NCP1379-D.PDF。 [3] NCP1380資料表。www.onsem.

本文作者现任能

67

com/pub\_link/Collateral/NCP1380-D.PDF -

www.Asta-info.net #f ## cmft##解解版 #面積### ET電子技術雜誌 ###